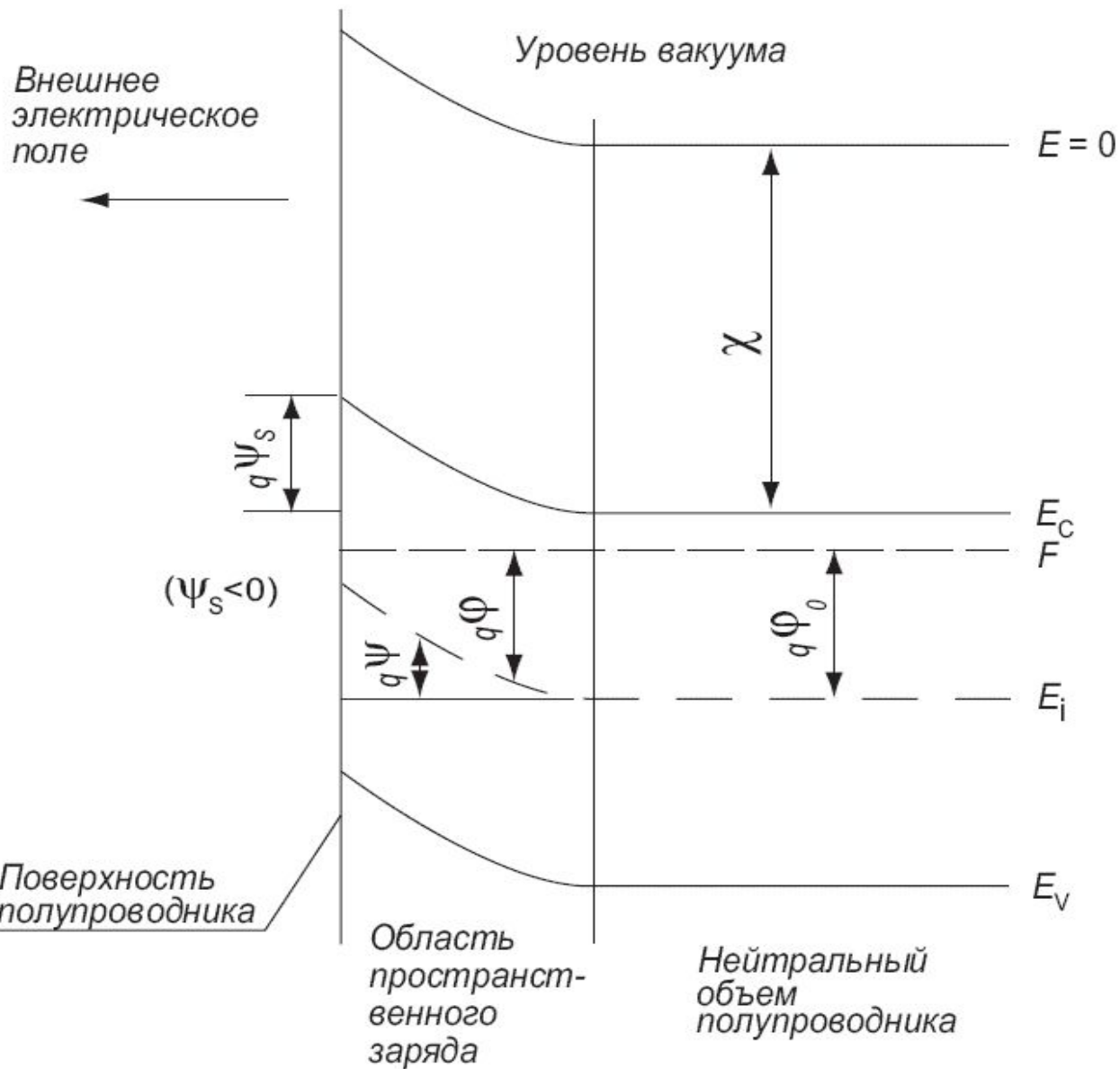
The page features several decorative, thin black lines. A large, vertical, teardrop-shaped curve is on the left side. A horizontal line with a slight upward curve is at the top. A long, thin, horizontal curve is at the bottom. A small, curved line is in the top right corner.

# Зонная диаграмма ОПЗ полупроводника

# ОПЗ

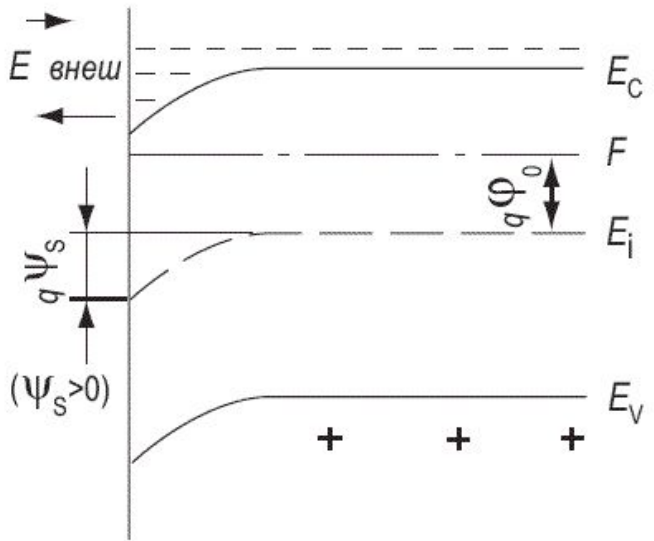
- - приповерхностная область полупроводника, в которой под действием внешнего поля возникает заряд.



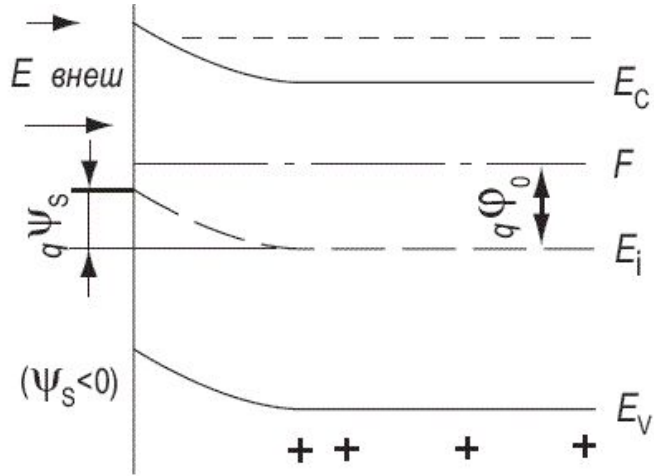
# Состояния поверхности полупроводника

- Обогащение
- Обеднение
- Слабая инверсия
- Сильная инверсия

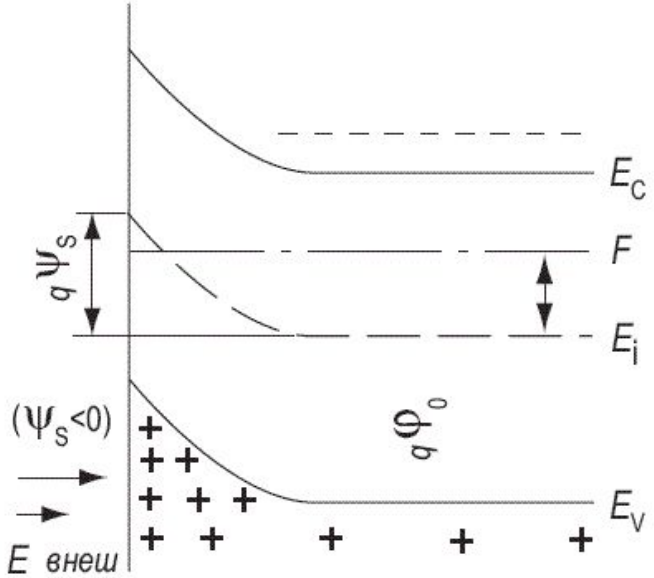
# П-ТИП



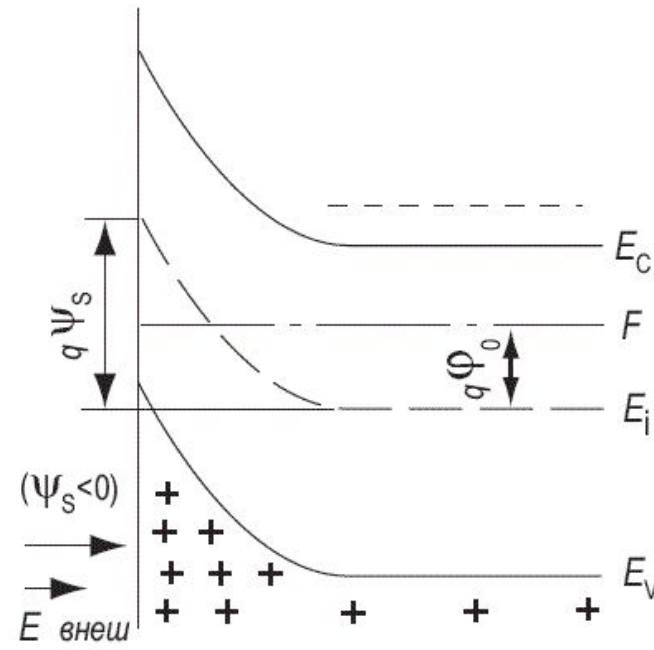
Обогащение



Обеднение



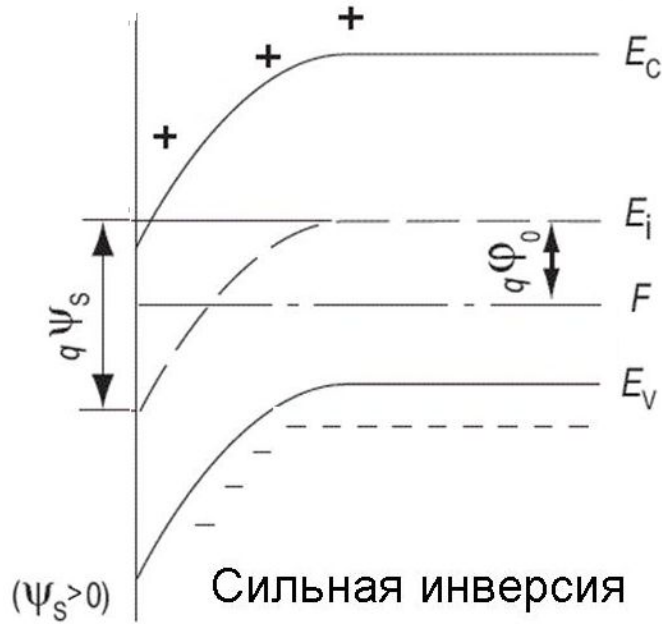
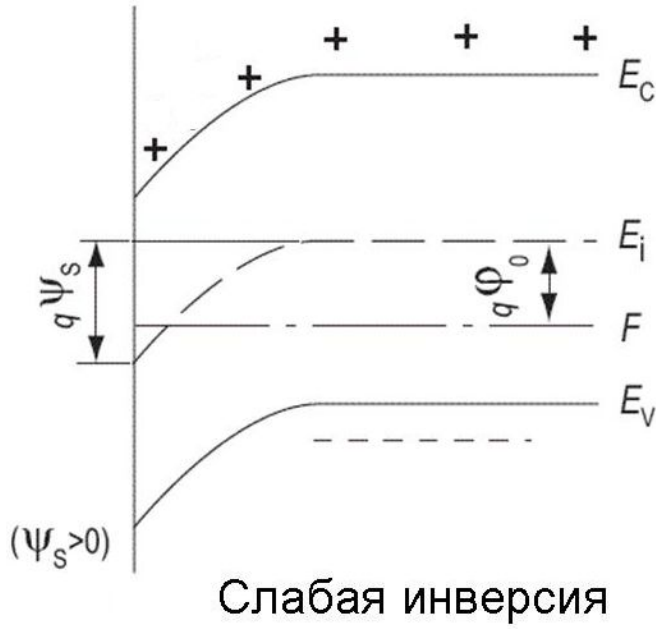
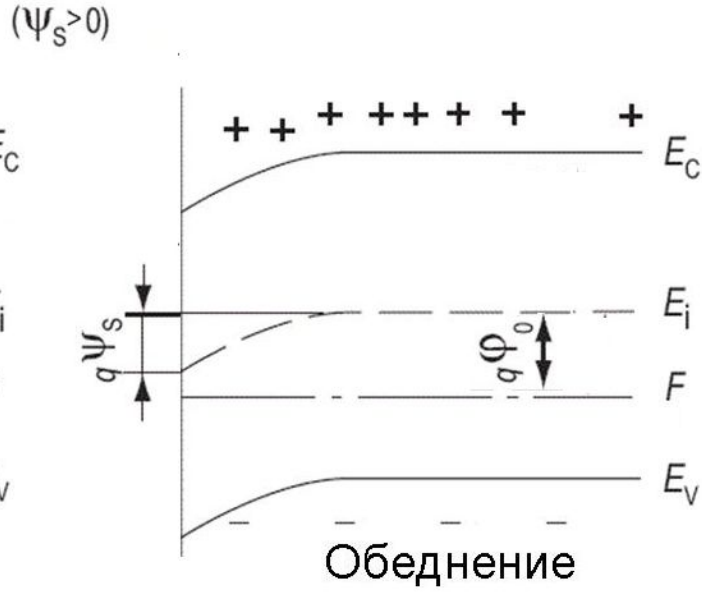
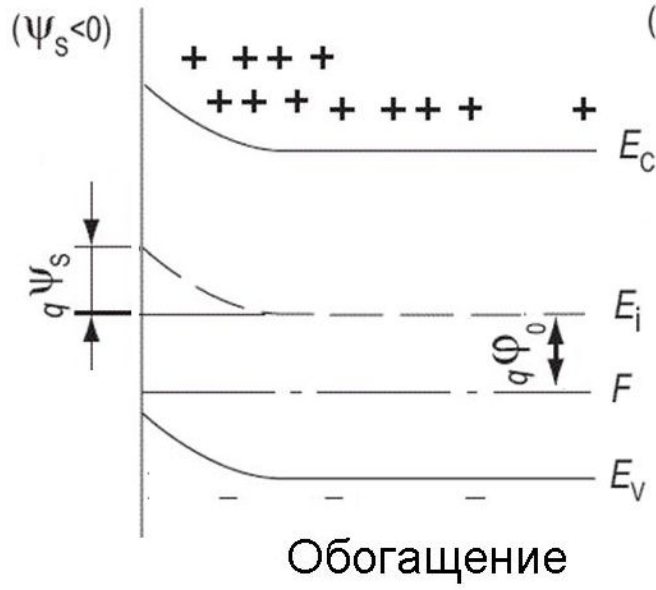
Слабая инверсия



Сильная инверсия

# П-ТИП

# Р-ТИП



# Р-ТИП

# Обогащение

- состояние поверхности полупроводника, когда поверхностная концентрация основных носителей больше, чем концентрация основных носителей в нейтральном объеме

# Обеднение

- состояние поверхности полупроводника, когда поверхностная концентрация неосновных носителей меньше, чем концентрация основных носителей в квазинейтральном объеме, но больше, чем поверхностная концентрация неосновных носителей



# ***Слабая инверсия***

- состояние поверхности полупроводника, когда поверхностная концентрация неосновных носителей больше, чем поверхностная концентрация основных, но меньше, чем концентрация основных носителей в квазинейтральном объеме

# ***Сильная инверсия***

- состояние поверхности полупроводника, когда поверхностная концентрация неосновных носителей больше, чем концентрация основных носителей в квазинейтральном объеме